Фазовые переходы в магнитном поле в доменной стенке четырехподрешеточного антиферромагнетика типа La₂CuO₄

© М.А. Шамсутдинов, В.Н. Назаров*

Башкирский государственный университет, 450074 Уфа, Россия *Институт физики молекул и кристаллов Российской академии наук, 450075 Уфа, Россия

(Поступила в Редакцию 12 января 1998 г.)

Изучено влияние внешнего магнитного поля на характеристики доменных границ в четырехподрешеточном антиферромагнетике La₂CuO₄. Показано, что при некоторых значениях полей возможен переход структуры одних типов доменных границ в другие. Определены критические поля перехода. Построена фазовая диаграмма устойчивости различных типов доменных стенок.

В настоящее время широко исследуются как теоретически, так и экспериментально металлооксидные соединения, к которым относится антиферромагнитный La₂CuO₄. При некоторой вариации химического состава он проявляет свойства высокотемпературной сверхпроводимости, при изучении природы которой большое внимание уделяется магнитным свойствам. Этот кристалл обладает тетрагональной решеткой с одной "октаэдрической молекулой" CuO₆ [1,2] и является четырехподрешеточным слабоколлинеарным антиферромагнетиком с температурой Нееля $T_{\rm N} \approx 325 \, {\rm K}$ [3]. В нем можно выделить CuO₂-плоскости, внутри которых все взаимодействия значительно превышают соответствующие взаимодействия между плоскостями. Это обстоятельство позволяет ввести безразмерные векторы ферромагнетизма m_i и антиферромагнетизма l_i (i = 1, 2) внутри СиО₂-слоев [2,4].

Структура доменных стенок в четырехподрешеточном антиферромагнетике La₂CuO₄ изучена теоретически в работе [4]. Найдены четыре типа доменных границ (ДГ), отличающихся законом поворота спинов в различных подрешетках. В [5] определены условия устойчивости, в [6] — скорость дрейфа этих ДГ в осциллирующем магнитном поле. Влияние внешнего магнитного поля на структуру ДГ в четырехподрешеточных антиферромагнетиках не исследовалось. Известно, что в объеме кристалла La₂CuO₄ магнитное поле индуцирует спин-переориентационные переходы [7]. Аналогичные переходы могут иметь место и в доменной стенке. Переход одного типа ДГ в другой, отличающийся плоскостью поворота спинов, обнаружен в нулевом поле в редкоземельных ортоферритах [8] и в поле, отличном от нуля, в коллинеарных антиферромагнетиках ромбической симметрии [9,10]. Такие перестройки структуры доменных стенок можно рассматривать как фазовые переходы, происходящие в ДГ [8]. Теоретически спин-переориентационные переходы в ДГ, индуцированные внешним магнитным полем, исследованы только в двухподрешеточной модели [11,12].

Настоящая работа посвящена исследованию влияния внешнего магнитного поля на характеристики 180° до-

менных стенок и на спин-переориентационные переходы в ДГ в четырехподрешеточном антиферромагнетике типа La_2CuO_4 .

1. Структура доменной стенки в магнитном поле

При изучении структуры ДГ будем исходить из следующего вида свободной энергии [2,6]:

$$W = 2M_0 \int \left\{ \sum_{j=1}^2 \left[\frac{1}{2} H_e m_j^2 + H_D[m_j l_j]_x + \frac{1}{2} \left(H_{AZ} l_{jz}^2 - H_{AY} l_{jy}^2 \right) - Hm_j + \frac{1}{4} \alpha M_0 (\partial l_j / \partial x_i)^2 \right] + h'_e l_1 l_2 - h'_a (l_{1x} l_{2x} - l_{1y} l_{2y}) \right\} dr.$$
(1)

Здесь декартова ось z параллельна направлению C_4 и перпендикулярна CuO₂-плоскостям, M_0 — намагниченность насыщения подрешеток, H_e , h'_e описывают соответственно однородное внутри- и межслоевое (со штрихом) обменное взаимодействие, H_D — поле Дзялошинского, H_{AZ} , H_{AY} — соответственно поля тетрагональной и ромбической анизотропии, h'_a — поле межплоскостной анизотропии, α — константа неоднородного обмена, H — внешнее магнитное поле; $x_i = x, y, z$.

В однородном состоянии в отсутствие внешнего магнитного поля при $\beta_1 = 2(H_{AZ} + H_{AY})/M_0 > 0$, $\beta_2 = 2(H_{AY} + H_D^2 H_e^{-1})/M_0 > 0$, $\delta_y = 2(h'_e + h'_a)/M_0 > 0$ векторы l_1 , l_2 коллинеарны оси у и антипараллельны друг другу [4,5]. В дальнейшем рассмотрим случай, когда напряженность внешнего магнитного поля, лежащая в CuO₂-плоскости, перпендикулярна вектору l_j , т.е. $H \parallel x$. При $H \ll H_e$ равновесное направление l_j в однородном состоянии не меняется, причем m_j остается много меньшим l_j . Описание структуры ДГ удобно проводить в сферической системе координат ($l_j^2 \approx 1$) $l_j = (-1)^{j+1}(\sin \theta_j \cos \varphi_j, \cos \theta_j, \sin \theta_j \sin \varphi_j)$. Исходя из (1), можно получить систему из четырех уравнений в переменных θ_j и φ_j , которая допускает два частных класса решений. Одному из них ($\varphi_1 = \varphi_2 = 0$) отвечает разворот векторов l_j в CuO₂, т. е. *ху*-плоскости. Второму классу решений ($\varphi_1 = \varphi_2 = \pi/2$) соответствует разворот векторов l_j в *хz*-плоскости. В случае отсутствия поля каждому классу решений соответствуют два типа ДГ, отличающихся законом поворота спинов. Поворот спинов в доменной стенке может происходить с нарушением и без нарушения антипараллельности векторов антиферромагнетизма l_j . Внешнее магнитное поле, как показывают расчеты, не меняет закона распределения l_j , существующего в нулевом поле [5]. Могут меняться только толщина и энергия ДГ. При повороте спинов, происходящем с сохранением антипараллельности, углы θ_j меняются по закону

$$\theta_1 = \theta_2 = 2 \operatorname{arctg} [\exp(\pi x / x_p)],$$
 (2)

где p = 1A при $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$, p = 2A в случае $\varphi_1 = \varphi_2 = \pi/2$. Зависимость толщины доменной стенки от внешнего поля в таком случае определяется выражениями

$$x_{1A} = \pi \left(\alpha / \left(\beta_2 + \chi_{\perp} H^2 / M_0^2 + \delta_y - \delta_x \right) \right)^{1/2},$$

$$x_{2A} = \pi \left(\alpha / \left(\beta_1 + \delta_y - \delta_z \right) \right)^{1/2},$$
 (3)

где $\delta_x = 2(h'_e - h'_a)/M_0$, $\delta_z = 2h'_e/M_0$, $\chi_{\perp} = 2M_0/H_e$. При H = 0 ДГ, описываемые (2), т.е. с индексом A, были названы акустическими [4].

В двух доменных стенках, в которых нарушается антипараллельность l_j ($\theta_1 = -\theta_2$), возрастает обменная энергия, и такие ДГ (1E, 2E) были названы обменными [4]. В них распределение θ_1 определяется также выражением вида (2). Только в этом случае толщины доменных границ, как показывают расчеты, равны

$$x_{1E} = \pi \left(\alpha / \left(\beta_2 + \chi_{\perp} H^2 / M_0^2 + \delta_y + \delta_x \right) \right)^{1/2},$$

$$x_{2E} = \pi \left(\alpha / (\beta_1 + \delta_y + \delta_z) \right)^{1/2}.$$
 (4)

Из (3) и (4) видно, что толщины доменных стенок 1A и 1E (с поворотом спинов в *ху*-плоскости) с ростом напряженности магнитного поля уменьшаются, а толщины стенок 2A и 2E (с поворотом спинов в *уz*-плоскости) не зависят от поля.

Величина энергии 180° ДГ обратно пропорциональна ее толщине, т.е. $E_p = 4\pi M_0^2 \alpha / x_p$ (p = 1A, 1E, 2A, 2E). Анализ показывает, что энергии двух доменных стенок (1A, 1E), в которых спины поворачиваются в CuO₂-плоскости, возрастают с увеличением напряженности магнитного поля. В случае двух других типов ДГ (2A, 2E), в которых спины поворачиваются в плоскости, параллельной оси C_4 и перпендикулярной направлению внешнего магнитного поля, поверхностная энергия стенки не зависит от поля.

Во всем образце вдоль магнитного поля появляется результирующая намагниченность, равная $M_x = 4M_0H/H_e$. Другие компоненты намагниченности в случае всех доменных стенок, кроме ДГ-2*E*, равны нулю. В объеме ДГ-2*E* существует намагниченность вдоль оси *y*, равная $M_y = (4M_0H_D/H_e) \operatorname{ch}^{-1}(\pi x/x_{2E})$. Это обстоятельство, по-видимому, может быть использовано для обнаружения ДГ-2*E*. Такая доменная стенка должна прийти в движение в градиентном магнитном поле.

2. Спин-переориентационные переходы в доменной границе

Переходим к рассмотрению вопроса устойчивости различных типов ДГ и фазовых переходов в доменной стенке, индуцированных внешним магнитным полем. Устойчивость ДГ может быть определена из анализа второй вариации энергии (1).

Проанализируем условия устойчивости одного из четырех типов ДГ, например 1А. Такая стенка, как показывает анализ, устойчива при

$$\beta_1 - \beta_2(H) + \delta_x - \delta_z \ge 0, \tag{5}$$

$$\beta_1 - \beta_2(H) + \delta_x + \delta_z \ge 0, \tag{6}$$

$$s - \left(\beta_2(H) - \delta_x - \delta_y\right) / \left(\beta_2(H) - \delta_x + \delta_y\right) \ge 0, \quad (7)$$

где

$$\beta_{2}(H) = \beta_{2} + \chi_{\perp}(H/M_{0})^{2}, \quad s = \left(\sqrt{1 + 4\Delta_{1A}} - 1\right)/2,$$
$$\Delta_{1A} = 2\beta_{2}(H)/\left(\beta_{2}(H) - \delta_{x} + \delta_{y}\right). \tag{8}$$

Равенства в (5)–(7) соответствуют линиям потери устойчивости ДГ. Аналогичные условия можно получить и для других типов доменных стенок. На рис. 1, 2 изображены области устойчивости различных ДГ на ($\delta_x \delta_z$)-плоскости. Рис. 1 соответствует случаю полей $H < H_k$, рис. 2 — $H > H_k$, где

$$H_k = M_0 [(\beta_1 - \beta_2) / \chi_\perp]^{1/2} = (H_e H_{AZ} - H_D^2)^{1/2} .$$
(9)

В поле $H = H_k$ на $(\delta_x \delta_z)$ -плоскости существует четвертая точка (точка, в которой сходятся области устойчивости четырех типов ДГ), возникающая при слиянии тройных точек *C* и *F* с *O* на рис. 1 (*C*₁ и *F*₁ с *O* на рис. 2). Существование тройных и четверных точек свидетельствует о том, что ДГ в четырехподрешеточном антиферромагнетике типа La₂CuO₄ с термодинамической точки зрения (правило фаз Гиббса) представляет собой многокомпонентную гетерогенную среду, где роли компонент играют внутри- и межплоскостная анизотропия, а также межплоскостное обменное взаимодействие.

При нарушении неравенства (5) происходит потеря устойчивости ДГ-1A и ее переход в ДГ-2A (линия AC на рис. 1, A_1C_1 на рис. 2). Поле перехода равно

$$H_1 = H_k \left(1 + \frac{\delta_x - \delta_z}{\beta_1 - \beta_2} \right)^{1/2}.$$
 (10)



Рис. 1. Фазовые диаграммы устойчивости доменных стенок при $H < H_k$. В области, ограниченной штриховыми линиями, устойчивы два типа ДГ: 1*A* и 1*E*.



Рис. 2. Фазовые диаграммы устойчивости доменных стенок при $H > H_k$. В области, ограниченной штриховыми линиями, устойчивы два типа ДГ: 2A и 2E.

В случае нарушения неравенства (6) имеет место переход ДГ-1*A* в ДГ-2*E* (линия *FD* на рис. 1, C_1D_1 на рис. 2). Поле такого перехода H_2 может быть представлено в виде

$$H_2 = H_k \left(1 + \frac{\delta_x + \delta_z}{\beta_1 - \beta_2} \right)^{1/2}.$$
 (11)

Отметим, что поле перехода ДГ-1*E* в ДГ-2*A* (ДГ-2*E*) можно получить заменой в $H_1(H_2)$ параметра δ_x на $-\delta_x$.

Такие перестройки структуры ДГ можно рассматривать как своеобразные спин-переориентационные переходы, происходящие только в доменной стенке. Эти переходы, как показано в случае редкоземельных ортоферритов [11], могут происходить путем фазового перехода как первого, так и второго родов. Следует отметить, что для определения характера фазового перехода в случае выше рассмотренных видов перестройки структуры ДГ необходим учет в (1) слагаемых, пропорциональных четвертой степени компонентов l_j . Значения полей фазовых переходов при $H_{AZ} \gg h'_e h'_a$ близки к H_k . Оценки в случае антиферромагнетика La₂CuO₄, согласно данным [13], показывают, что $H_k \approx 5 \cdot 10^3$ Oe, а значения полей фазовых переходов должны лежать в интервале $10^3 - 10^4$ Oe.

Теперь рассмотрим переход ДГ-1*A* в ДГ-1*E*. При $H < H_k$ этот переход осуществляется путем фазового перехода первого рода (линия *CF* на рис. 1) при $\delta_x = 0$. В случае $H > H_k$ ситуация сильно изменяется и переход ДГ-1*A* в ДГ-1*E* может происходить через ДГ-2*A* ($\delta_z > 0$) или ДГ-2*E* ($\delta_z < 0$) (см. рис. 2). Наконец, проанализируем переход ДГ-2*A* в ДГ-2*E*. При $H < H_k$ такой переход может осуществляться только через ДГ-1*A* ($\delta_x > 0$) или ДГ-1*E* ($\delta_x < 0$). В случае $H > H_k$ перестройка структуры ДГ-2*A* в ДГ-2*E* происходит как фазовый переход первого рода (линия *F*₁*C*₁ на рис. 2) при $\delta_z = 0$. Итак, при критическом поле H_k , соответствующем четверной точке на ($\delta_x \delta_z$)-плоскости, может измениться характер фазовых переходов.

Следует указать также и на возможность обнаружения магнитного фазового перехода в доменной стенке. Перестройка структуры ДГ может быть обнаружена путем исследования зависимости восприимчивости образца от внешнего магнитного поля. При приближении H к полям фазового перехода, как было показано в случае ортоферритов [11], восприимчивость должна возрастать. Таким методом экспериментально был обнаружен фазовый переход в ДГ коллинеарного антиферромагнетика [12].

Таким образом, проведенные исследования показывают, что с увеличением напряженности внешнего магнитного поля при некоторых критических значениях ДГ с поворотом спинов в CuO2-плоскости теряют свою устойчивость. Происходит перестройка структуры ДГ, которую можно рассматривать как своеобразный спин-переориентационный переход. Характер этих переходов может измениться при некотором поле, равном полю существования четверной точки, т.е. точки, в которой сходятся области устойчивости четырех типов ДГ. Выше полей фазовых переходов устойчивыми становятся ДГ с поворотом спинов в плоскости, параллельной оси С₄ и перпендикулярной магнитному полю. В результате этого с ростом напряженности внешнего магнитного поля, параллельной CuO₂-плоскости и перпендикулярной направлению векторов антиферромагнетизма в доменах, области устойчивости ДГ-1А и ДГ-1Е на ($\delta_x \delta_z$)-плоскости сужаются, а области устойчивости ДГ-2А и ДГ-2Е расширяются.

Работа поддержана грантом МОПО РФ в области фундаментального естествознания.

Список литературы

- [1] А.С. Боровик-Романов, А.И. Буздин, Н.М. Крейнес, С.С. Кротов. Письма в ЖЭТФ **47**, *11*, 600 (1988).
- [2] В.Г. Барьяхтар, В.М. Локтев, Д.А. Яблонский. Препринт ИТФ-88-81Р. Киев (1988).
- [3] Б.И. Белевцев, Н.В. Далакова, А.С. Панфилов. ФНТ 23, 4, 375 (1997).
- [4] В.Г. Барьяхтар, А.Л. Сукстанский, Д.А. Яблонский. ФТТ 32, 4, 1231 (1990).
- [5] А.Л. Сукстанский. Препринт ДонФТИ-90-20. Донецк (1990).
- [6] В.С. Герасимчук, А.Л. Сукстанский. ФНТ 20, 2, 142 (1994).
- [7] В.Н. Криворучко, Т.Е. Примак. ФНТ 19, 8, 871 (1993).
- [8] А.В. Залесский, А.М. Саввинов, И.С. Желудев, А.Н. Иващенко. ЖЭТФ 68, 4, 1449 (1975).
- [9] А.Н. Богданов, В.А. Галушко, В.Т. Телепа, Д.А. Яблонский. Письма в ЖЭТФ 40, 11, 453 (1984).
- [10] А.Н. Богданов, В.Г. Телепа, П.П. Шатский. Д.А. Яблонский. ЖЭТФ 90, 5, 1738 (1986).
- [11] М.А. Шамсутдинов, М.М. Фарзтдинов, А.А. Халфина. ФТТ 31, 2, 112 (1989).
- [12] А.Н. Богданов, А.И. Пузыня. ФТТ 38, 7, 2072 (1996).
- [13] В.Е. Катаев, Е.Ф. Куковицкий, Ю.И. Таланов, Г.Б. Тейтельбаум. Письма в ЖЭТФ 48, 2, 96 (1988).